

Invenția se referă la dispozitive sensibile la gaze, în special la senzori de gaze toxice în bază de semiconductori și poate fi utilizată la detectarea gazelor toxice, cum ar fi dioxidul de azot cu concentrație mică.

Senzorul conține un strat subțire de telur sau aliajele lui depus pe o peliculă de semiconductor calcogenic vitros. Pelicula de semiconductor vitros este depusă pe o suprafață metalică în calitate de contraelectrod.